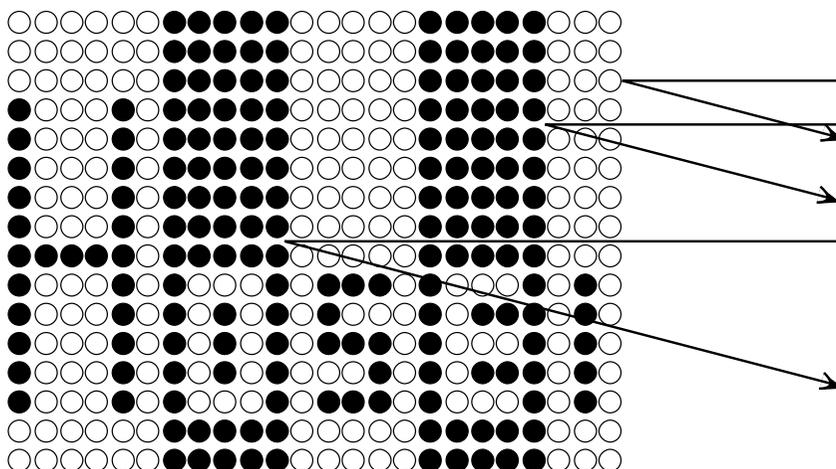


# 第 44 回法政大学 イオンビーム工学研究所シンポジウム

The 44<sup>th</sup> Symposium on Materials Science and Engineering  
Research Center of Ion Beam Technology  
Hosei University

## PROGRAM



期日 2025年12月10日(水)

会場 法政大学小金井キャンパス (※)

・招待講演及び一般講演 (ショート講演) : マルチメディアホール

・一般講演 (ポスター発表) : 東館体育館前フロア

主催 法政大学イオンビーム工学研究所

協賛 日本物理学会

応用物理学会

日本アイソトープ協会 (順不同)

※招待講演、ショート講演をオンラインにて聴講を希望する場合は、開催前日までに下記宛にお申込み下さい。

Email : [ion-sympo@ml.hosei.ac.jp](mailto:ion-sympo@ml.hosei.ac.jp) (法政大学イオンビーム工学研究所)

1. 低次元 Sb 系ハライドペロブスカイト化合物の合成と光触媒特性評価  
秋山壮吾<sup>1</sup>、飯高史章<sup>1</sup>、門田佑介<sup>1</sup>、緒方啓典<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学生命科学部環境応用化学科、  
<sup>2</sup>法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター
2. リグニン誘導体の蛍光特性  
津原由衣<sup>1</sup>、緒方啓典<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学生命科学部環境応用化学科、  
<sup>2</sup>法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター
3. 非晶質  $\text{Sb}_2\text{S}_3$  /  $\text{g-C}_3\text{N}_4$  複合体の可視光下における光触媒活性評価  
飯高史章<sup>1</sup>、秋山壮吾<sup>1</sup>、門田佑介<sup>1</sup>、緒方啓典<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学生命科学部、  
<sup>2</sup>法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター
4.  $\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{TiO}_2$  複合体の光触媒活性評価  
門田佑介<sup>1</sup>、秋山壮吾<sup>1</sup>、飯高史章<sup>1</sup>、緒方啓典<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学生命科学部環境応用化学科、  
<sup>2</sup>法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター
5. 圧力可変 He 環境下でのレーザー分光実験に向けたレーザーアブレーション法による Rb 原子発生  
伊藤なつみ<sup>1</sup>、松尾由賀利<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学大学院理工学研究科、<sup>2</sup>法政大学理工学部
6. レーザーアブレーションにより発生する Rb 原子の放出挙動の時間分解観測  
山本敦貴<sup>1</sup>、松尾由賀利<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>法政大学大学院理工学研究科システム理工学専攻、<sup>2</sup>法政大学理工学部
7. Er 賦活ストロンチウムアルミネート赤外蛍光体の発光特性と評価  
小原裕太、中村俊博  
法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻
8. 蛍光電気化学発光素子における励起状態のキナクリドン誘導体の効率的生成法の検討  
樽松一樹、笠原崇史  
法政大学理工学研究科電気電子工学専攻
9. Photodegradation of Methylene Blue Molecules Catalyzed by Graphene Oxides with Various Chemical Structures  
Xiao Li<sup>1</sup>, Yuya Miyake<sup>1</sup>, Yoshiaki Matsuo<sup>2</sup>, Kazuyuki Takai<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>Dept. of Appl. Chem., Graduate School of Sci. and Eng., Hosei University, Tokyo, Japan  
<sup>2</sup>Dept. of Appl. Chem., Graduate School of Eng., University of Hyogo, Hyogo, Japan  
<sup>3</sup>Research Center of Ion Technology, Hosei University, Tokyo, Japan
10. イオンビーム照射による欠陥導入エピタキシャルグラフェンへのガス吸着効果  
鈴岡大晟<sup>1</sup>、水谷彰吾<sup>1</sup>、吉田巧<sup>1</sup>、三宅裕也<sup>2</sup>、高井和之<sup>1,2,3</sup>  
<sup>1</sup>法政大学大学院理工学研究科、<sup>2</sup>法政大学生命科学部、  
<sup>3</sup>法政大学イオンビーム工学研究所

**招待講演 I****11 : 00 ~****招待講演 I**

ダイヤモンド半導体へ室温イオン注入したドーパント P 原子の  
新しいアニール手法による n 型電氣的活性化  
— MeV 級イオン照射による新しいアニール手法の導入 —  
神奈川大学理学部

中田 穰治

(昼 休 憩)

12 : 00 ~ 13 : 00

**招待講演 II****13 : 00 ~****招待講演 II**

学生に送る 研究者としての人生で運がドンドン良くなる方法  
— 化合物半導体の研究・開発の経験から —  
法政大学イオンビーム工学研究所

三島 友義

(休 憩)

**ショート講演 II (各 4 分以内)****14 : 00 ~**

11. 単層 MoS<sub>2</sub> に対する直接/間接 Fe<sup>+</sup>ビーム照射の効果  
濱本英幹<sup>1</sup>、Yangzhou Zhao<sup>1</sup>、日高拓海<sup>1</sup>、西村智朗<sup>2</sup>、高井和之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>法政大学大学院理工学研究科、<sup>2</sup>法政大学イオンビーム工学研究所
12. *In-situ* 硫黄蒸着による MoS<sub>2</sub> の硫黄空孔修復に対する試料温度の影響  
吉田巧<sup>1</sup>、濱本英幹<sup>1</sup>、石黒康志<sup>2</sup>、高井和之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>法政大学大学院理工学研究科、<sup>2</sup>防衛大学校電気電子工学科
13. R-SNMS 分析の自動化及び遠隔化システムの開発  
佐々木翼<sup>1</sup>、石井陽介<sup>1</sup>、徳永陸<sup>1</sup>、富田英生<sup>2</sup>、石倉大輔<sup>2</sup>、坂本哲夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>工学院大学、<sup>2</sup>名古屋大学
14. 炭素質コンドライト隕石マトリックスの FIB-TOF-SIMS 分析  
増田真盛<sup>1</sup>、白井 嗣恩<sup>1</sup>、坪 京弥<sup>2</sup>、坂本 哲夫<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>工学院大学大学院、<sup>2</sup>工学院大学
15. FIB-TOF-SIMS を用いた CV 隕石のマトリックス領域における Al-rich 粒子および Fe 粒子分析  
白井 嗣恩<sup>1</sup>、増田真盛<sup>1</sup>、坪 京弥<sup>2</sup>、坂本 哲夫<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>工学院大学大学院、<sup>2</sup>工学院大学
16. Two-dimensional optical scan of Ce<sup>3+</sup> in YAG within nanowindows  
S. Abe<sup>1,2</sup>, K. Takano<sup>1,2</sup>, Y. Maeda<sup>1,2</sup>, M. Kawahara<sup>1,2</sup>, J. Ishihara<sup>3</sup>, M. Kohda<sup>3-6</sup>,  
S. Ikeda<sup>2,5,7,8</sup>, H. Ohno<sup>1,2,7,9</sup>, S. Fukami<sup>1,2,5-7,10,11</sup>, and S. Kanai<sup>1,2,4-6,10,12</sup>  
<sup>1</sup>Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan  
<sup>2</sup>Department of Electronic Engineering, Tohoku University, Sendai, 980-8579, Japan  
<sup>3</sup>Department of Material Science, Tohoku University, Sendai, 980-8579, Japan  
<sup>4</sup>Division for the Establishment of Frontier Sciences of Organization for Advanced Studies at Tohoku University, 980-8577, Japan  
<sup>5</sup>Center for Science and Innovation in Spintronics, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan  
<sup>6</sup>National Institute for Quantum Science and Technology, Takasaki, 370-1207, Japan  
<sup>7</sup>Center for Innovative Integrated Electronic System, Tohoku University, Sendai, 980-8572, Japan  
<sup>8</sup>Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan

<sup>9</sup>Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan

<sup>10</sup>WPI-Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan

<sup>11</sup>Inamori Research Institute for Science, Kyoto, 600-8411, Japan.

<sup>12</sup>PRESTO, Japan Science and Technology Agency, Kawaguchi, 332-0012, Japan

17. 入射原子番号に依存する電子阻止断面積の解析モデル

望月和浩、西村智朗、三島友義、堀切文正、太田博

法政大学イオンビーム工学研究所

18. MARLOWE によるイオン注入シミュレーション

青木正彦、南川英輝、横田一広、須山篤志

株式会社イオンテクノセンター

19. 強誘電体  $\text{HfO}_2$  を用いた MIS HEMT の電荷注入による閾値制御

太田博<sup>1,2</sup>、高谷信一郎<sup>1</sup>、堀切文正<sup>1</sup>

<sup>1</sup>法政大学、<sup>2</sup>デバイズテック株式会社

20. 時間構造をもつ荷電粒子の照射下における材料の組織変化

義家敏正<sup>1</sup>、木野村淳<sup>2</sup>、堀史説<sup>1</sup>、西村智朗<sup>3</sup>

<sup>1</sup>大阪公立大学大学院工学研究科、<sup>2</sup>京都大学複合原子力科学研究所、

<sup>3</sup>法政大学イオンビーム工学研究所

ポスターセッション

15:00~16:30

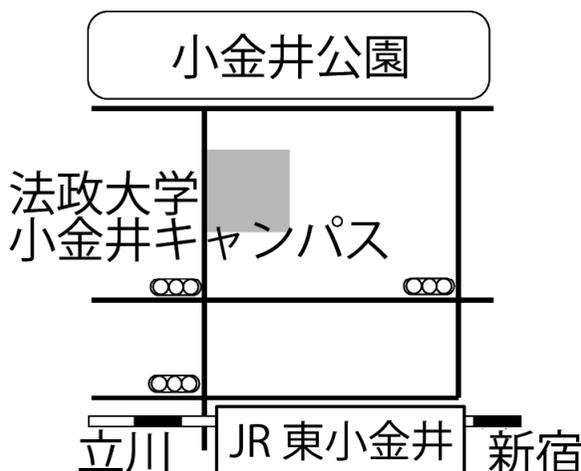
於 東館体育館前フロア

交通案内

JR 東小金井駅北口より徒歩12分

京王バスまたは CoCo バス 「法政大学」下車

\*車でのご来場はご遠慮ください



法政大学イオンビーム工学研究所

〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2

Tel: 042-387-6094 Fax: 042-387-6095

E-mail: ion-sympo@ml.hosei.ac.jp